

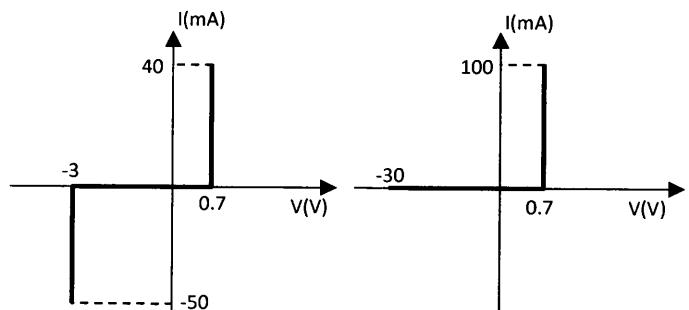
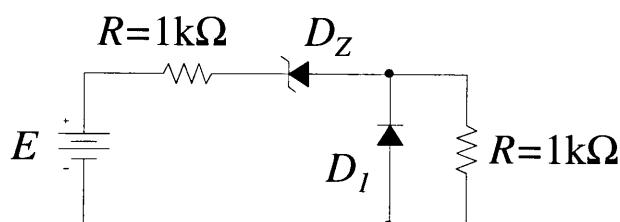


Asignatura:	ELECTRÓNICA ANALÓGICA	Fecha:	13-12-2012
Apellidos:	- SOLUCIÓN -	Nombre:	
Prueba:	Prueba de Evaluación Intermedia 2	Nº de lista:	

Duración: 1 h

¡Atención!: No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente

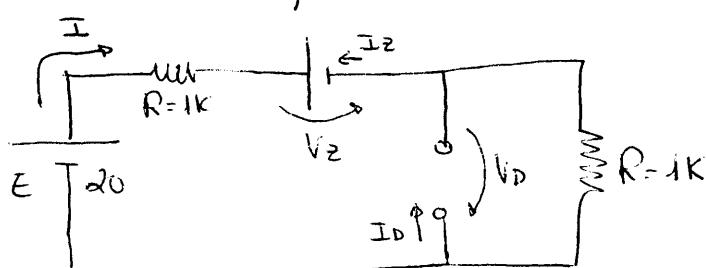
**Problema 1.** - Dado el circuito de la figura, donde además se muestran las características de los diodos, se pide:



- (2 puntos)- Calcular el punto de trabajo de ambos diodos si  $E=20$  V.
- (3 puntos)- Hallar el rango de valores entre los que puede variar el generador E ( $E>0$  y  $E<0$ ) para que no se dañe ninguno de los diodos.

a) Puntos de trabajo

Supongo }  $D_2$  en ZENNER  
}  $D_3$  en OFF



$$I = \frac{E - V_z}{2R} = \frac{20 - 3}{2} = 8.5 \text{ mA}$$

Comprobamos:

D2       $I_z = -I = -8.5 \text{ mA} \rightarrow$  Si está en ZENNER.

D3       $V_D = -RI = -8.5 \text{ V} \rightarrow$  Si está en OFF.

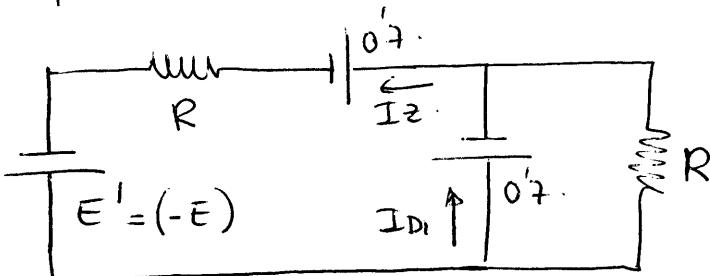
Por lo tanto, los puntos de trabajo son:

$$D_2 = \left\{ \begin{array}{l} -3V, -8.5 \text{ mA} \\ \text{Zona ZENNER} \end{array} \right\}$$

$$D_3 = \left\{ \begin{array}{l} -8.5 \text{ V}, 0 \text{ A} \\ \text{CORTADO} \end{array} \right\}$$

- \* Si  $E > 0$  (valor grande), se mantiene la suposición del apartado anterior, y el circuito equivalente:
  - dimitación del ZENNER  $\rightarrow I_Z \geq -50 \text{ mA}$  ( $I \leq 50 \text{ mA}$ )
  - dimitación de DS  $\rightarrow V_D = -RI \geq -30 \text{ V} \rightarrow I \leq 30 \text{ mA}$ .
  - da condición más restrictiva la fija DS :
$$I = \frac{E - V_Z}{2R} = \frac{E - 3}{2} \leq 30 \rightarrow E \leq 63 \text{ V.}$$

- \* Si  $E < 0$  (valor en módulo grande), suponemos
    - D2 en ON.
    - DS en ON.
- Invierte la polaridad de E en el cto equivalente para trabajar con valor positivo (módulo de E).



- $I_Z = \frac{E' - 0.7 - 0.7}{R} = \frac{E' - 1.4}{R}$ . Debe cumplir:  
 $I_Z = \frac{E' - 1.4}{R} \leq 40 \rightarrow E' \leq 41.4 \text{ V} \rightarrow E \geq -41.4 \text{ V}$

- $I_{DS} = I_Z - \frac{0.7}{R} = \frac{E' - 1.4 - 0.7}{R} = \frac{E' - 2.1}{R}$ . Debe cumplir:  
 $I_{DS} = \frac{E' - 2.1}{R} \leq 100 \rightarrow E' \leq 102.1 \text{ V} \rightarrow E \geq -102.1 \text{ V}$

Es más restrictiva la condición impuesta por D2:  $E \geq -41.4 \text{ V}$ .

Resumiendo:

$$-41.4 \text{ V} \leq E \leq 63 \text{ V}$$

Se rompe D2

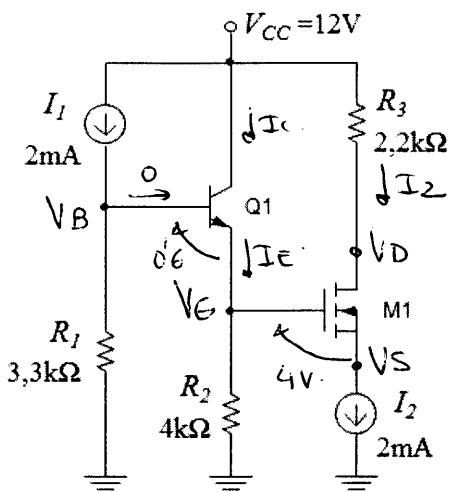
Se rompe DS

**Problema 2.- (3 puntos)** Dado el circuito de polarización de la figura adjunta, obtenga el punto de trabajo de ambos transistores.

Datos:  $BJT: V_{BE} = 0.6 \text{ V}$  y  $\beta \gg$   
 $MOSFET: k = 4 \text{ mA/V}^2$  y  $V_t = 3 \text{ V}$

**Problema 3.-** Dibuje y calcule los parámetros del modelo en pequeña señal de los siguientes transistores (indique con claridad las unidades de dichos parámetros):

- (1 punto)- MOS con  $V_t = 2 \text{ V}$ ,  $k = 3 \text{ mA/V}^2$  y  $V_A = 50 \text{ V}$ , polarizado en  $I_D = 4 \text{ mA}$ .
- (1 punto)- BJT pnp con  $\beta = 100$  y  $V_A = 150 \text{ V}$ , polarizado en  $|I_C| = 10 \text{ mA}$ .



Problema 2. Suponemos ambos tristos en ACTIVA.

$$\text{Como } \beta \gg \Rightarrow I_B = 0$$

$$V_B = I_S \cdot R_S = 2 \cdot 3 = 6 \text{ V}$$

$$V_G = V_B - 0.6 = 6 \text{ V} \rightarrow I_E = I_C = V_G / R_2 = 6 / 4 = 1.5 \text{ mA}$$

Si M1 está en activa con  $I_S = I_D = 2 \text{ mA}$ , entonces:

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_t)^2 \rightarrow 2 = \frac{4}{2} (V_{GS} - 3)^2 \rightarrow V_{GS1} = 4 \text{ V}$$

$V_{GS2} = 2 \text{ V}$ . NO VACUO EN ACTIVA.

$$\text{Ahora } V_S = V_G - 4 = 2 \text{ V}$$

$$\text{y } V_D = -R_3 I_2 + V_{CC} = -2 \cdot 2 + 12 = 4 \text{ V}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{Q_1 \left\{ \begin{array}{l} V_{CE} = V_{CC} - V_G = 6 \text{ V} \\ I_C = 1.5 \text{ mA} \end{array} \right.}$$

Como  $V_{CE} > V_{CESAT}$ , ESTA EN ACTIVA

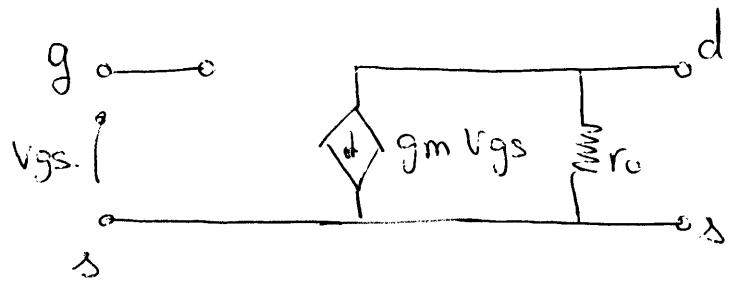
$$\boxed{M_1 \left\{ \begin{array}{l} V_{DS} = V_D - V_S = 5 \text{ V} \\ I_D = 2 \text{ mA} \end{array} \right.}$$

Como  $V_{DSAT} = V_{GS} - V_t = 1 \text{ V}$  y  
 $V_{DS} > V_{DSAT} \Rightarrow$  ESTA EN ACTIVA.



### Problema 3.

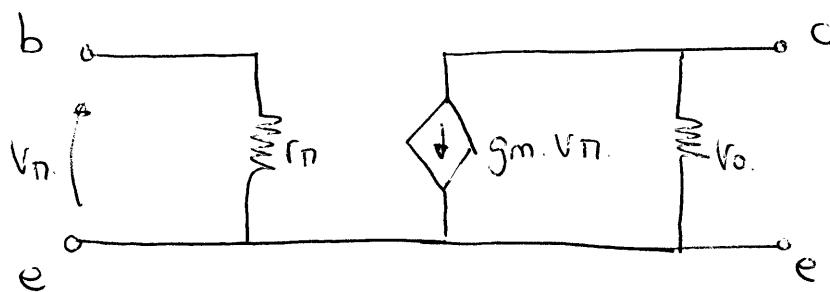
a) MOS



$$g_m = \sqrt{2kI_D} = 489 \text{ mA/V}$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_D} = 125 \text{ k}\Omega$$

b) BJT



$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 400 \text{ mA/V}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{0.4} = 250 \text{ }\Omega$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = 150 \text{ k}\Omega$$